

# 固体辐射物理研究室知识库

ALL

精确检索请加双引号

Go

首页 | 研究单元&专题 | 作者 | 文献类型 | 学科分类 | 知识图谱 | 新闻&公告

XJIPC OpenIR

> 固体辐射物理研究室



## 一种电路级总剂量辐射效应仿真方法



郑齐文; 崔江维; 李小龙; 魏莹; 余学峰; 李豫东; 郭旗



2022-08-05

专利权人

中国科学院新疆理化技术研究所

授权日期

2022-08-05

专利类型

发明专利

摘要

本发明涉及一种电路级总剂量辐射效应仿真方法,该方法包括晶体管偏置电压提取、晶体管平均偏置电压计算、晶体管辐射陷阱电荷计算、晶体管总剂量效应模型参数更新、电路总剂量辐射损伤仿真、电路总剂量辐射损伤时间连续反馈计算。该方法的理论基础是晶体管辐射照偏置条件不同,总剂量辐射损伤特性不同,进而影响电路的总剂量辐射损伤。该方法的优势在于根据电路中晶体管的偏置状态,计算晶体管总剂量辐射损伤,实现电路总剂量辐射效应的精确仿真。

申请日期

2020-10-20

申请号

CN202011125626.7

公开(公告)号

112214953B

代理机构

乌鲁木齐中科新兴专利事务所(普通合伙) 65106

文献类型

专利

条目标识符

http://ir.tianshanzw.cn/handle/365002/8701

专题

固体辐射物理研究室

推荐引用方式

郑齐文,崔江维,李小龙,等. 一种电路级总剂量辐射效应仿真方法. 112214953B[P]. 2022-08-05.

GB/T 7714

条目包含的文件

条目无相关文件。

所有评论 (0)

[发表评论/异议/意见]

暂无评论

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

### 个性服务

推荐该条目

★ 保存到收藏夹

查看访问统计

导出为Endnote文件

### 谷歌学术

谷歌学术中相似的文章

[郑齐文]的文章

[崔江维]的文章

[李小龙]的文章

### 百度学术

百度学术中相似的文章

[郑齐文]的文章

[崔江维]的文章

[李小龙]的文章

### 必应学术

必应学术中相似的文章

[郑齐文]的文章

[崔江维]的文章

[李小龙]的文章

### 相关权益政策

暂无数据

### 收藏/分享



QQ客服



官方微博



反馈留言